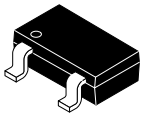
N-Channel JFET

25 V, 20 to 40 mA, 40 mS, CPH3

CPH3910



CPH3
CASE 318BA

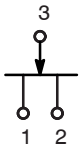
特長

- V_{GDS}: −25 V max.
- $|y_{fs}|$: 40 mS typ.
- C_{iss}: 6.0 pF typ.
- N_F: 2.1 dB typ.
- これは鉛フリーのデバイスです

用途

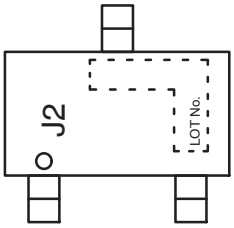
- AM チューナ RF 増幅用
- ローノイズアンプ用

ELECTRICAL CONNECTION



1: Source
2: Drain
3: Gate

MARKING DIAGRAM



ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
CPH3910−TL−E	CPH3 (Pb−Free)	3 000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D.

絶対最大定格 (T_A = 25°C)

記号	項目	定格値	単位
V_{DSX}	ドレイン・ソース電圧	25	V
V_{GDS}	ゲート・ドレイン電圧	−25	V
I_G	ゲート電流	10	mA
I_D	ドレイン電流	50	mA
P_D	許容損失	400	mW
T_j	接合部温度	150	°C
T_{stg}	保存周囲温度	−55 ~ +150	°C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(参考訳)
最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。これらの定格値を超えた場合は、デバイスの機能性を損ない、ダメージが生じたり、信頼性に影響を及ぼす危険性があります。

電気的特性 (T_A = 25°C)

記号	項目	条件	最小	標準値	最大	単位
$V_{(BR)GDS}$	ゲート・ドレイン降伏電圧	I_G = −10 μA, V_{DS} = 0 V	−25			V
I_{GSS}	ゲートしゃ断電流	V_{GS} = −10 V, V_{DS} = 0 V			−1.0	nA
V_{GS}(off)	ゲート・ソースしゃ断電圧	V_{DS} = 5 V, I_D = 100 μA	−0.6	−1.2	−1.8	V
I_{DSS}	ドレイン電流	V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 0 V	20		40	mA
$\|y_{fs}\|$	順伝達アドミタンス	V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 0 V, f = 1 kHz	30	40		mS
C_{iss}	入力容量	V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 0 V, f = 1 MHz		6.0		pF
C_{rss}	帰還容量	V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 0 V, f = 1 MHz		2.3		pF
N_F	雑音指数	V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 0 V, f = 100 MHz		2.1	2.8	dB

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.
(参考訳)
製品パラメータは、特別な記述が無い限り、記載されたテスト条件に対する電気的特性で示しています。異なる条件下で製品動作を行った時には、電気的特性で示している特性を得られない場合があります。

電気的特性の代表例

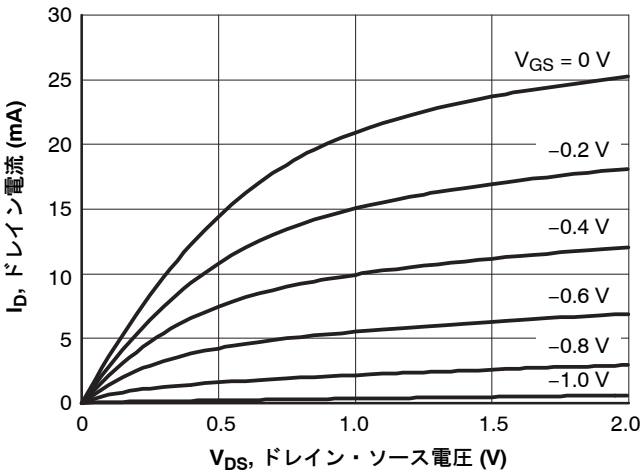


図 1. $I_D - V_{DS}$

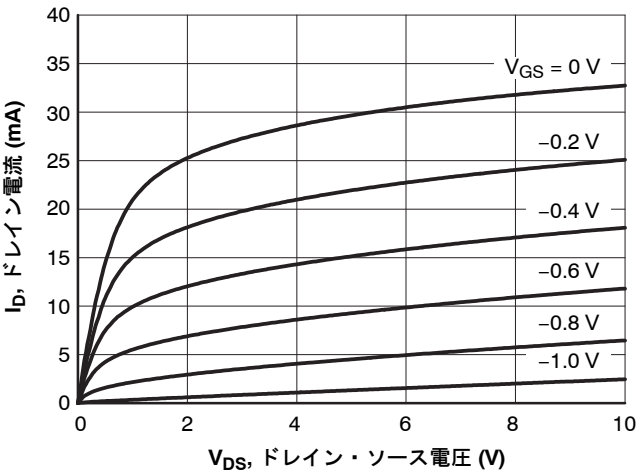


図 2. $I_D - V_{DS}$

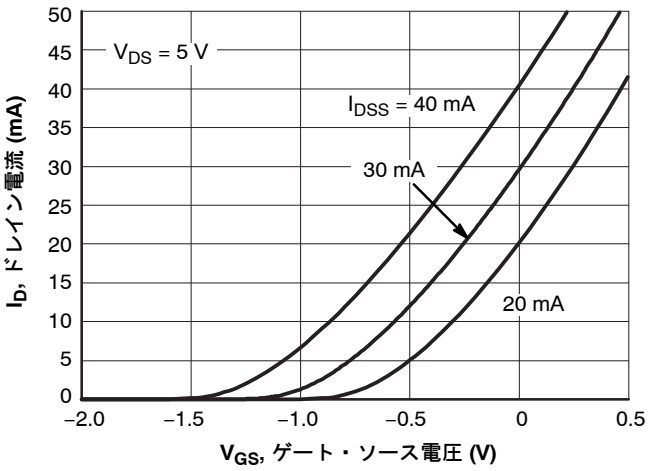


図 3. $I_D - V_{GS}$

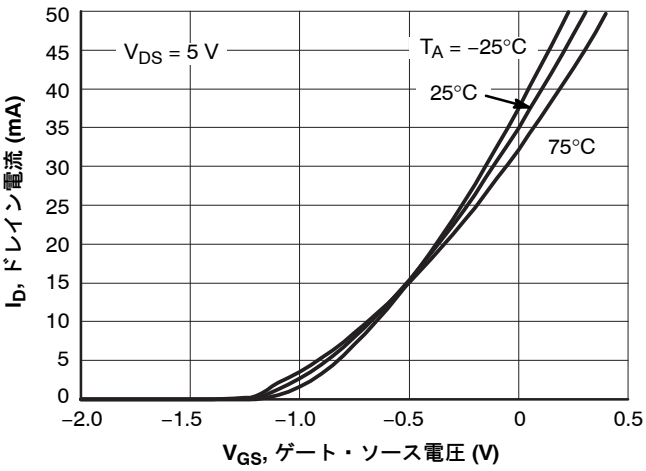


図 4. $I_D - V_{GS}$

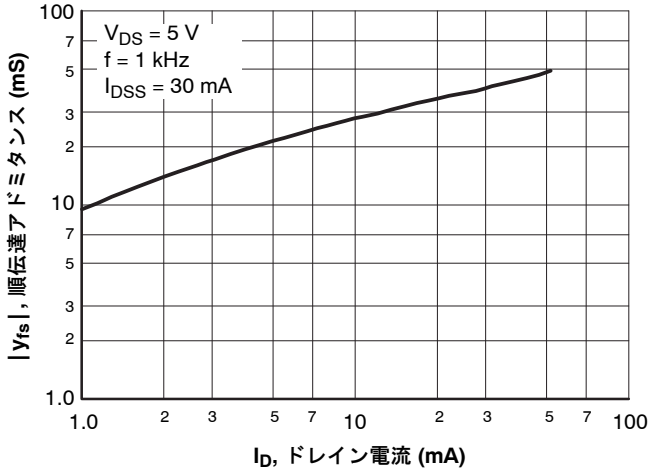


図 5. $|y_{fs}| - I_D$

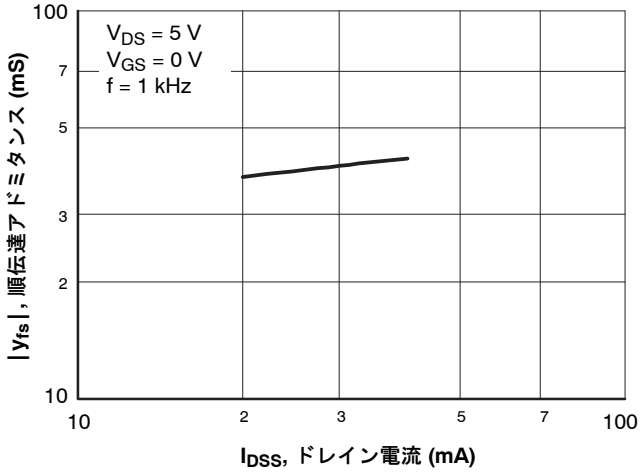


図 6. $|y_{fs}| - I_{DSS}$

電気的特性の代表例 (つづき)

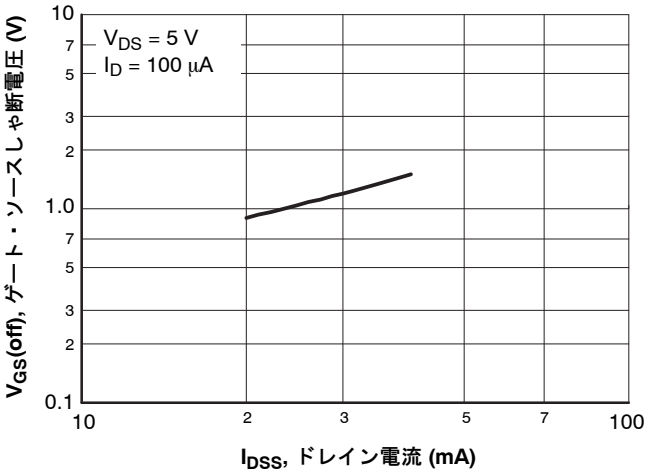


図 7. $V_{GS(off)} - I_{DSS}$

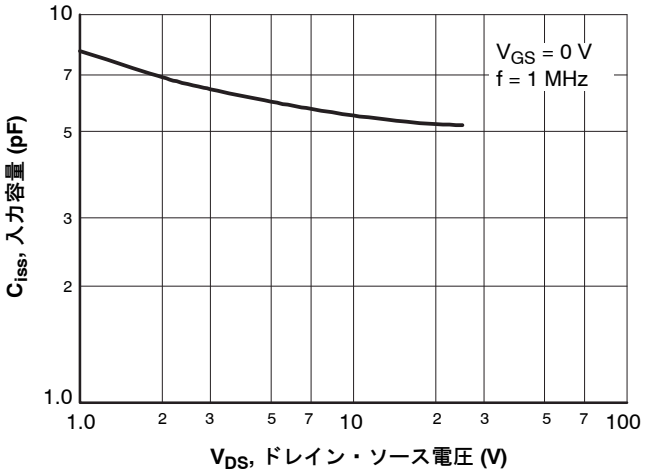


図 8. $C_{iss} - V_{DS}$

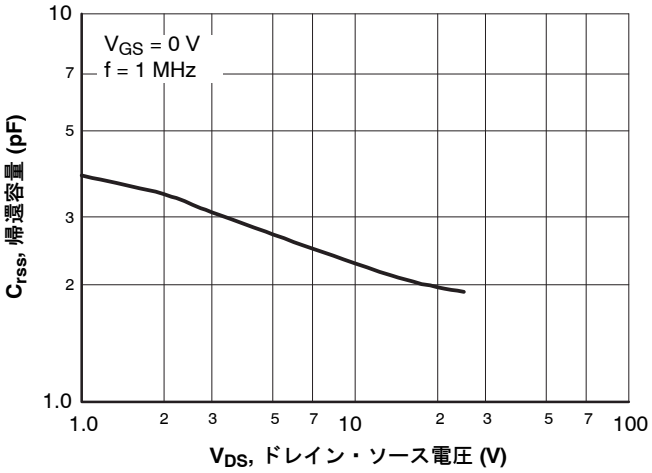


図 9. $C_{rss} - V_{DS}$

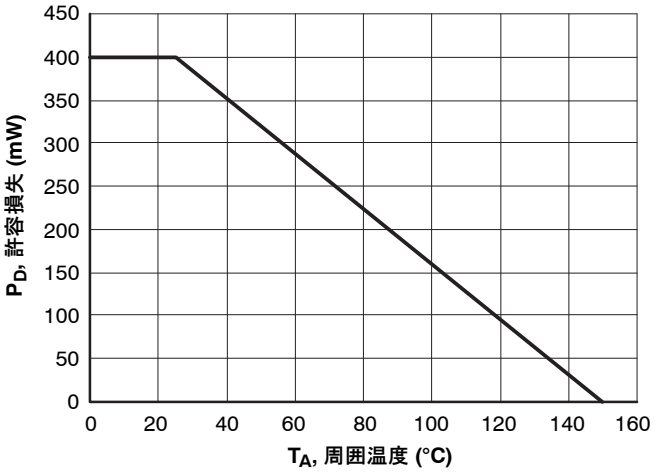
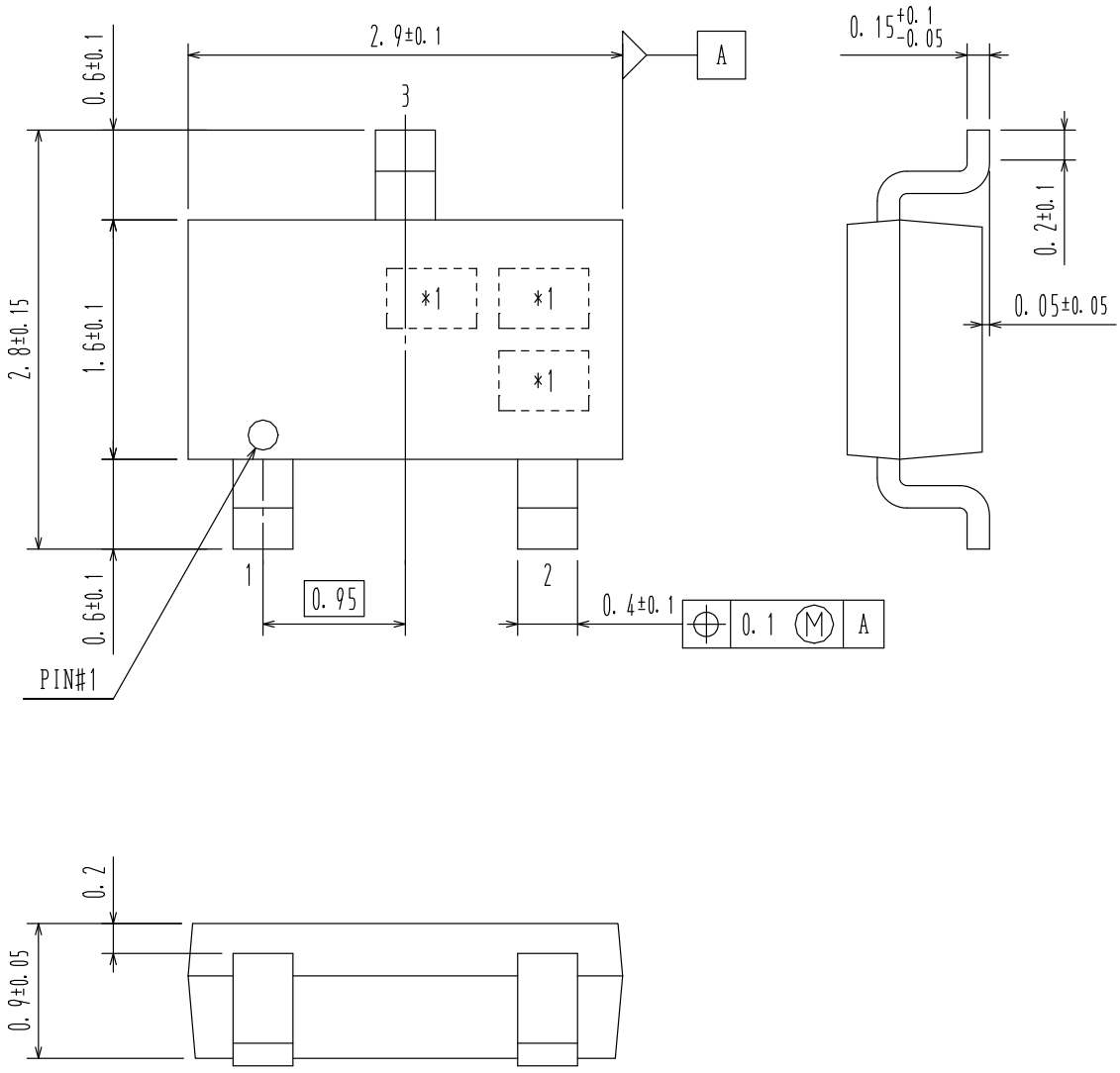


図 10. $P_D - T_A$

CPH3
CASE 318BA
ISSUE O

DATE 30 NOV 2011



DOCUMENT NUMBER:	**98AON65437E**	Electronic versions are uncontrolled except when accessed directly from the Document Repository. Printed versions are uncontrolled except when stamped "CONTROLLED COPY" in red.	
DESCRIPTION:	**CPH3**		**PAGE 1 OF 1**

ADDITIONAL INFORMATION

TECHNICAL PUBLICATIONS:
Technical Library: www.onsemi.com/design/resources/technical−documentation
onsemi Website: www.onsemi.com

ONLINE SUPPORT: www.onsemi.com/support
For additional information, please contact your local Sales Representative at www.onsemi.com/support/sales